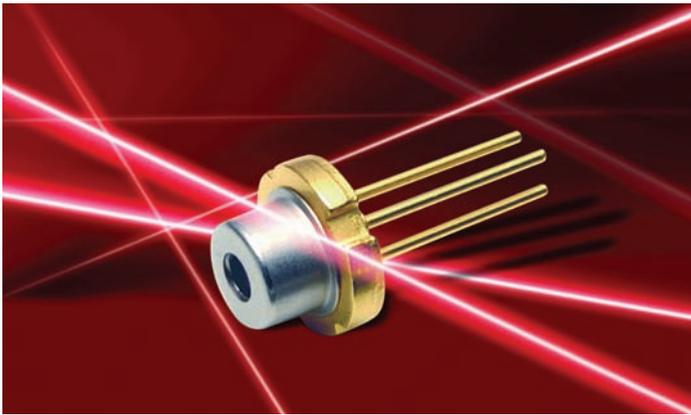




El nuevo Diodo Laser Rojo a 638 nm, de Mitsubishi Electric es el de mayor potencia del mundo en su clase



Mitsubishi Electric ha presentado un nuevo diodo laser rojo, denominado ML520G72. Este dispositivo ofrece la más alta potencia de salida obtenida en comparación con otros diodos laser de longitud de onda en la región de 638nm y por lo tanto se adapta perfectamente a las aplicaciones destinadas a pico proyectores u otros sistemas de visualización portátiles que requieren una fuente de luz roja con alto brillo. La potencia de salida del ML520G72 es de 500 mW, ello supondrá una mejora substancial en el diseño de proyectores LED para aplicaciones portátiles. El ML520G72 puede proporcionar un flujo luminoso de hasta 60 lúmenes (lm). Por el momento los proyectores basados en LEDs se caracterizan por ofrecer sólo 10 lm.

Además, el ML520G72 ofrece una eficiencia de conversión electro óptica del 32% a 500 mW., a una temperatura ambiente de 25°C. Esto ayuda a reducir el consumo de energía y por lo tanto extender la vida útil de la batería.

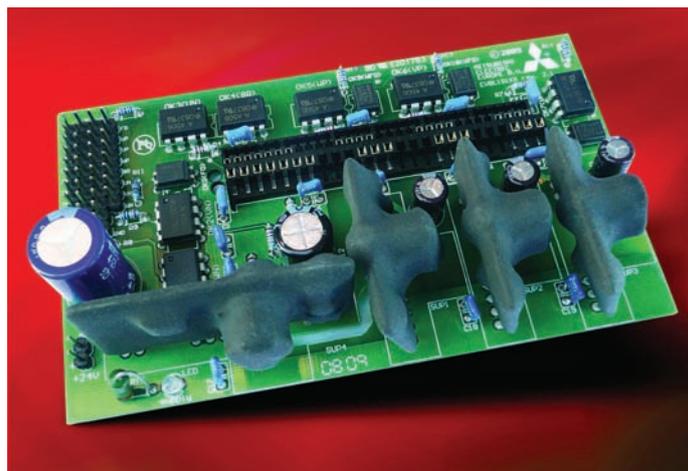
En el rango de temperatura de -5 a 40 ° C, el ML520G72 puede producir hasta 500 mW de onda continua (CW) de potencia. El dis-

positivo es aún capaz de proporcionar luz láser pulsada de 600 mW a 50 ° C, cuando se opera con un ciclo de trabajo máximo de 25% en las frecuencias superiores a 50 Hz. Para operación CW a 25 ° C la corriente umbral es de 170mA. La corriente nominal a 500mW/2.3V es de 680mA. El diodo láser rojo está integrado en un encapsulado estándar CAN de 5.6mm.

Ref. N° 1009888

Placa de evaluación para IPMs de la serie L1/S1

Mitsubishi Electric presenta la placa de evaluación para Intelligent Power Modules (IPMs) para toda la serie L1/S1. La nueva placa llamada EVBL1S1XX permite que el ingeniero de diseño pueda testear



las características y prestaciones de los IPMs de Mitsubishi Electric.

La tarjeta puede ser utilizada como un diseño de referencia con respecto a trazado y componentes.

La placa

El circuito EVBL1SXX 's se basa en las recomendaciones de interfaz y circuito de driver de las especificaciones de la serie L1/S1 IPM. Dispone de dos conectores IPM diferentes para los dispositivos L1 y S1. Las señales de de control se conectan mediante un conector de paso 2.54 mm. Únicamente precisa de 24 V para alimentar la placa de evaluación EVBL1S1XX, incluyendo el control y la electrónica del propio IPM.

Además incluye aislamiento eléctrico DC/DC entre la entrada de control de la placa de evaluación y el modulo IP además de aislamiento de señales mediante opto-acopladores.

Los IPMS

La serie L1 IPMs de Mitsubishi Electric está fabricada con chips IGBT de bajas pérdidas basados en la tecnología full gate CSTBT™ (Carrier-Stored Trench Gate Bipolar Transistor). El circuito incluye funciones de protección contra cortocircuitos, sobrecalentamiento y caídas de tensión.

Además de ser compatible con los IPMs de la anterior serie L, esta nueva serie ofrece otras mejoras como una mejor relación entre el estado de conducción y las pérdidas de conmutación, un mejor control de la temperatura del IGBT

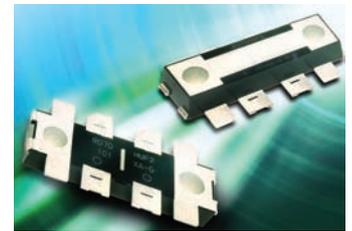
y un ciclo de potencia mejorado.

La nueva serie L1 IPMs está disponible para 600V/1200V en tres encapsulados distintos para corrientes entre 25 A y 300 A.

Ref. N° 1009889

Nuevos módulos MOSFET de 12.5V para celulares

Mitsubishi Electric presenta dos nuevos MOSFET de 12.5V de alta potencia. Los dos dispositivos discretos, RD70HUF2 y RD35HUF2, están diseñados para ser utilizados como amplificadores de frecuencia de alta potencia en 2-way radios comerciales que operen en 25W y 50W respectivamente. Ambos modelos están disponibles en VHF o UHF y son conformes a la tecnología de montaje superficial (SMT).



Los dos nuevos dispositivos son dispositivo de potencia y alta eficiencia. El RD70HUF2 tiene una potencia de salida de 75W a 84W en UHF y VHF y está optimizado para las radios de 50W. El RD35HUF2 ofrece una potencia de salida de 43W a 45W en UHF y VHF y está optimizado para las radios clase 25W. La eficiencia de consumo, (la tasa de la electricidad convertida a potencia de RF por los amplificadores) de al menos 60% en UHF y 70% en VHF para los dos dispositivos, permitirá a la próxima generación de radios comerciales (celulares) ofrecer un consumo de energía inferior al actual.

El RD70HUF2 y el RD35HUF2 cumplen los estándares SMT, se suministran en encapsulados de plástico moldeado sin plomo, aptos para su uso en un proceso de soldadura por reflujo. Además, los dispositivos se suministran embandados en cinta y carrete, lo que los hace adecuados para su insertado SMT. Ambos dispositivos utilizan nuevos encapsulados con baja resistencia y optimizados en coste.

Estos nuevos módulos son conformes con RoHS

Ref. N° 1009890